

**2024年3月期第3四半期(2023年4月～12月)  
決算説明資料**

**2024年2月9日**

**株式会社 KOKUSAI ELECTRIC**

# 注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

## ■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

## ■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けますが、当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限り、利益への影響は軽微です。

## ■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。

## ■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

## ■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



# 2024年3月期第3四半期連結決算概要

## 2024年3月期第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイスの在庫調整が進み、メモリーデバイス単価の上昇も見られ始めたことから、市況は底を打ったと認識。成熟ノードへの活発な投資に加え、DRAM、Logic/Foundryも回復基調へ。
- 当社3Qは前年同期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。受注も計画通り3Qから回復。

## 2024年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、25/3期はWFEを上回る成長を想定。
- 当社売上・利益は1Qを底に、受注は2Qを底に回復に転じており、24/3期通期予想に変更なし。成熟ノード向け投資が活発で売上収益を下支え。今後は先端デバイス向けも回復へ。
- 令和6年能登半島地震による業績への影響は軽微。

# 連結業績サマリー

3Qはメモリー市場低迷の影響により前期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。案件構成変化の影響はあったものの、売上総利益率は40%以上を継続。

(億円)	23/3期				24/3期						
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	1Q	2Q	3Q	前年同期比	前四半期比	3Q累計	前年同期比
売上収益	560	644	652	1,856	327	450	540	△17.3%	+19.9%	1,317	△29.1%
売上総利益	231	275	264	769	143	199	217	△17.5%	+9.3%	559	△27.3%
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	41.4%	43.6%	44.2%	40.3%	△0.1pts	△3.9pts	42.5%	+1.0pts
調整後営業利益	147	181	172	500	56	110	124	△27.7%	+12.4%	290	△41.9%
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	26.9%	17.2%	24.5%	23.0%	△3.3pts	△1.5pts	22.1%	△4.8pts
調整後四半期利益	108	125	122	355	38	73	91	△25.4%	+24.6%	202	△43.1%
調整後四半期利益率	19.3%	19.4%	18.7%	19.1%	11.6%	16.2%	16.9%	△1.8pts	+0.6pts	15.3%	△3.8pts
営業利益	130	164	155	449	40	94	107	△31.2%	+13.9%	241	△46.4%
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	24.2%	12.2%	20.9%	19.8%	△4.0pts	△1.0pts	18.3%	△5.9pts
税引前四半期利益	129	164	157	450	37	91	107	△31.4%	+17.5%	236	△47.5%
税引前四半期利益率	23.0%	25.5%	24.0%	24.2%	11.4%	20.3%	19.9%	△4.1pts	△0.4pts	17.9%	△6.3pts
四半期利益	96	113	111	320	27	62	79	△28.5%	+28.5%	167	△47.7%
四半期利益率	17.1%	17.5%	17.0%	17.2%	8.1%	13.7%	14.7%	△2.3pts	+1.0pts	12.7%	△4.5pts
研究開発費	27	33	29	89	29	30	31	+5.2%	+1.3%	90	+1.4%
設備投資	7	29	22	57	51	21	105	3.9倍	4.1倍	176	2.1倍
減価償却費	25	26	26	77	26	27	28	+7.4%	+4.5%	81	+5.3%

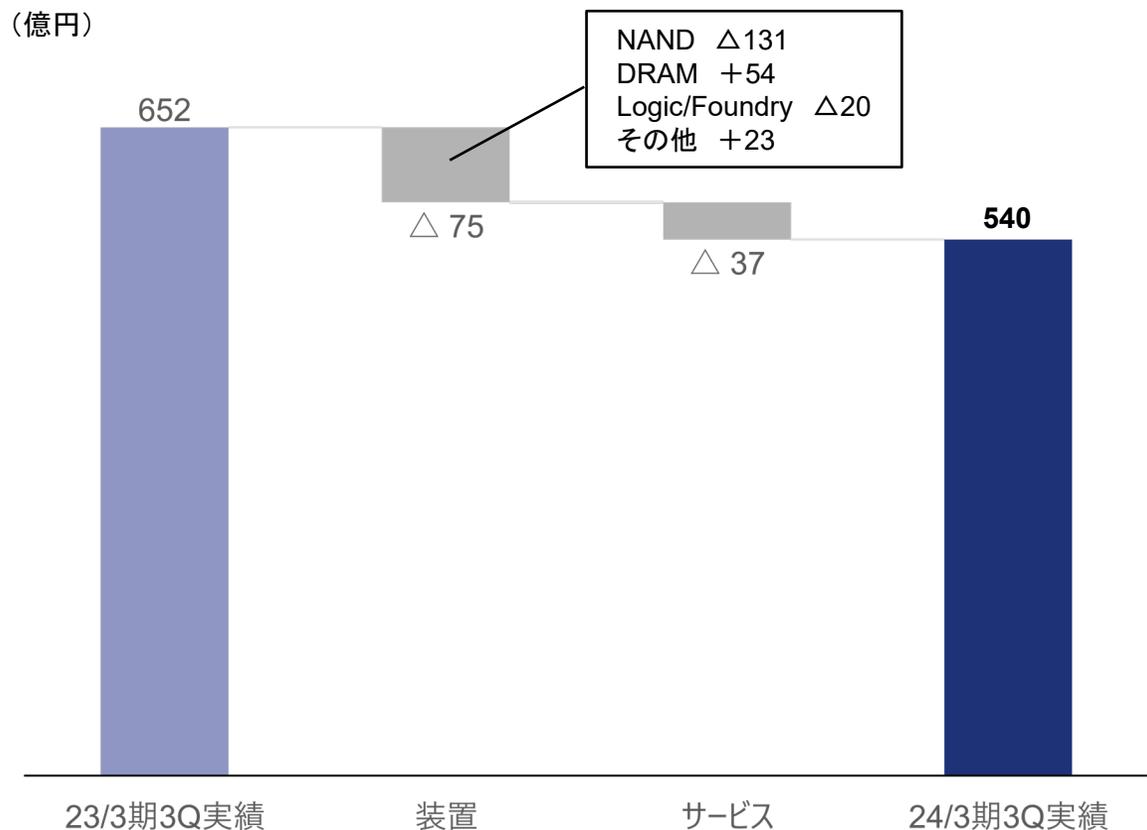
# 2024年3月期第3四半期実績 増減要因

NANDに対する投資抑制により、売上収益は前年同期比▲113億円。

販売減少の影響により、調整後営業利益は前年同期比▲48億円。

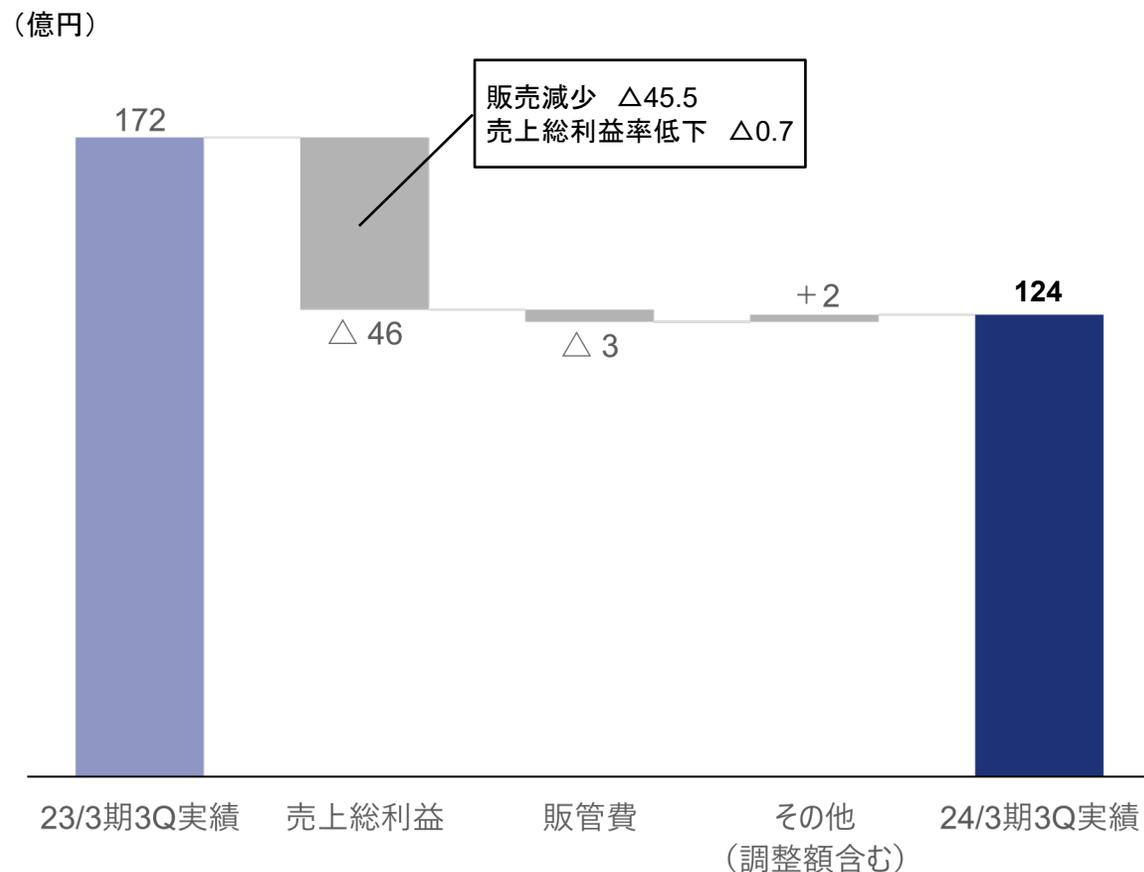
## 売上収益

(億円)



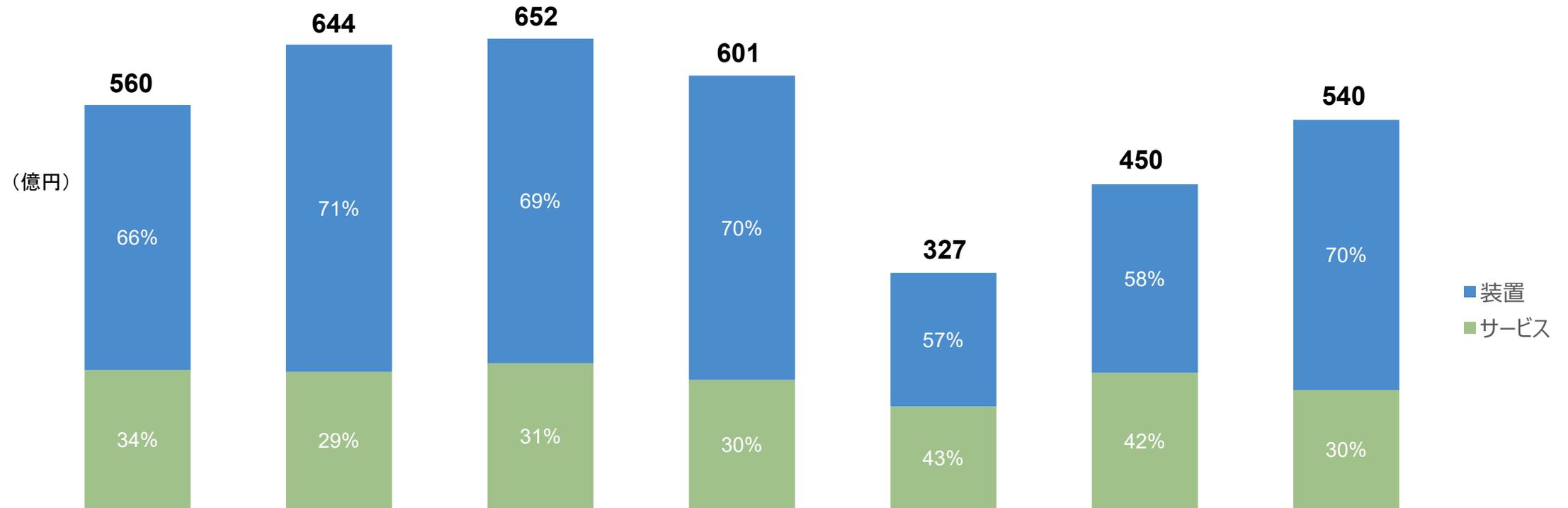
## 調整後営業利益

(億円)



# 売上収益 ビジネス別

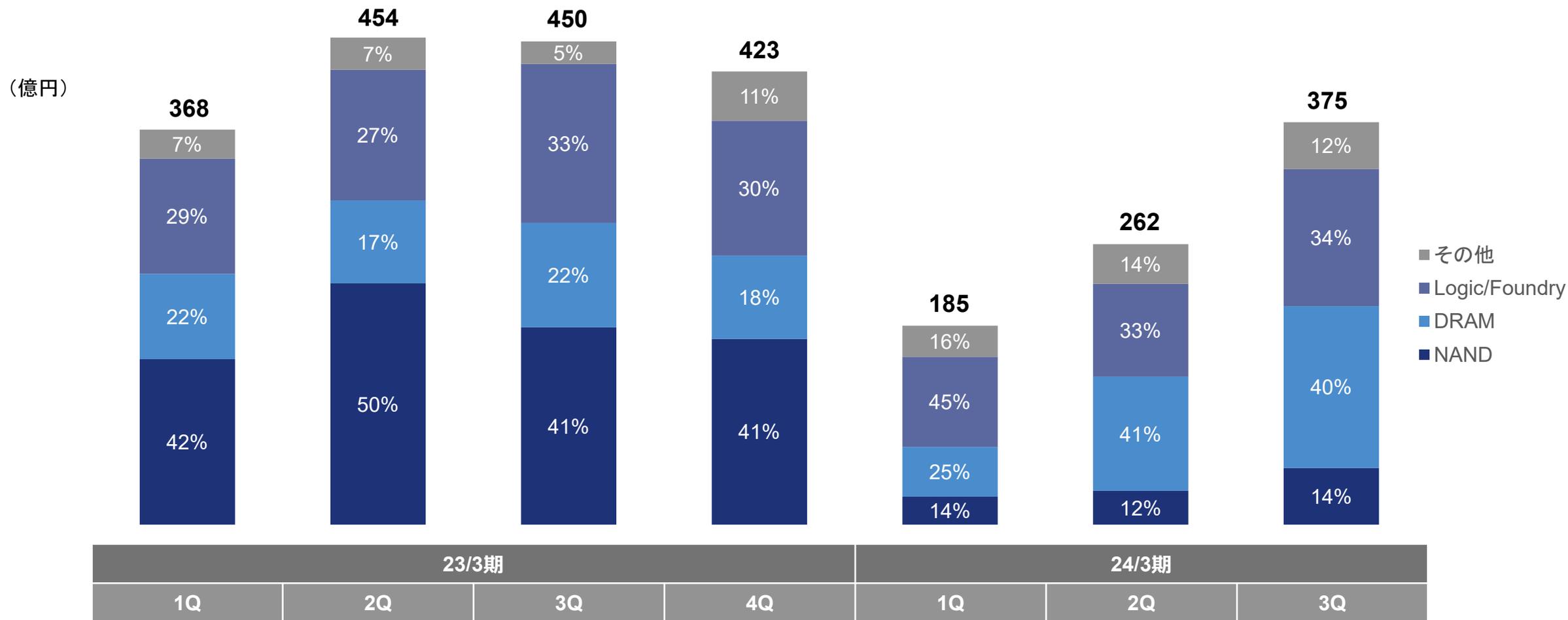
3Qのビジネス別売上構成は、装置売上の回復により装置：サービス＝70%：30%に平常化。



(億円)	23/3期				24/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
装置	368	454	450	423	185	262	375
サービス	192	190	202	178	142	188	164

# 売上収益 アプリケーション別（装置のみ）

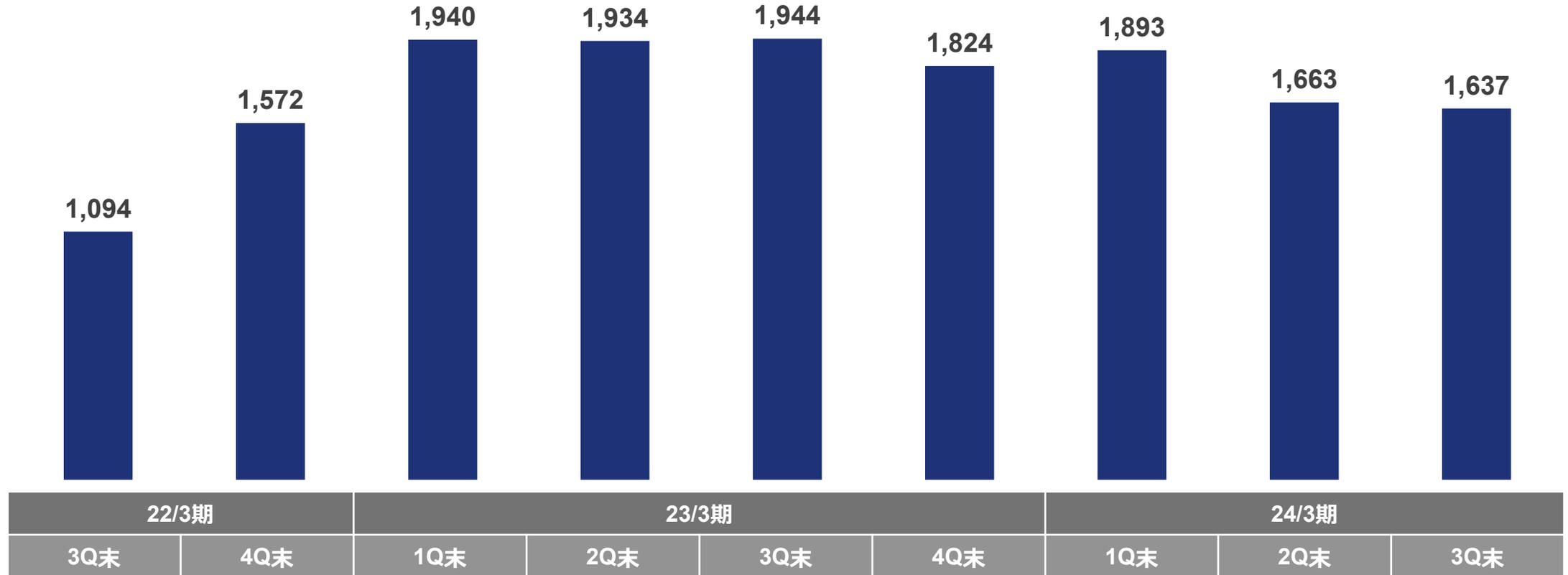
3Qのアプリケーション別売上構成は、NANDへの投資抑制が続く中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資回復により、NAND:DRAM:Logic/Foundry+その他=14%:40%:46%。



# 受注残高の推移

受注は計画通り2Qを底に3Qから回復。長納期案件の売上転換も進み、受注残高は平常化へ。  
その結果、3Q末の受注残高は2Q末と概ね同水準。

(億円)

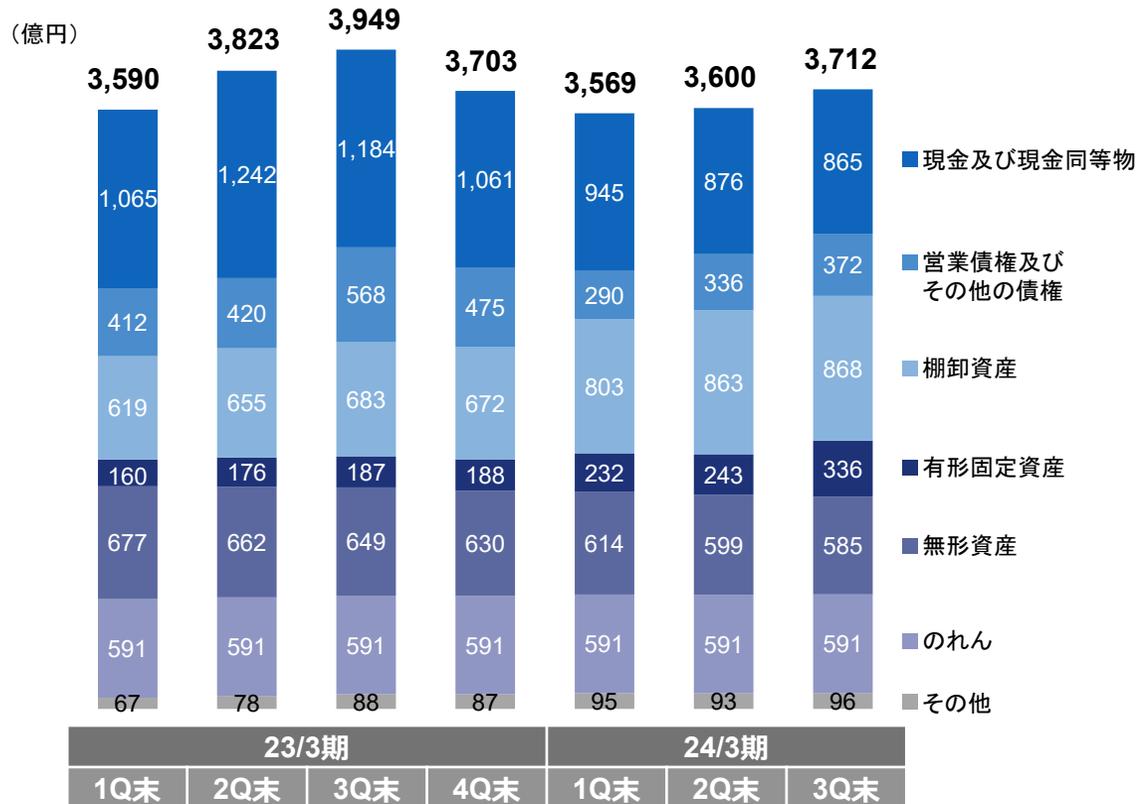


# 貸借対照表

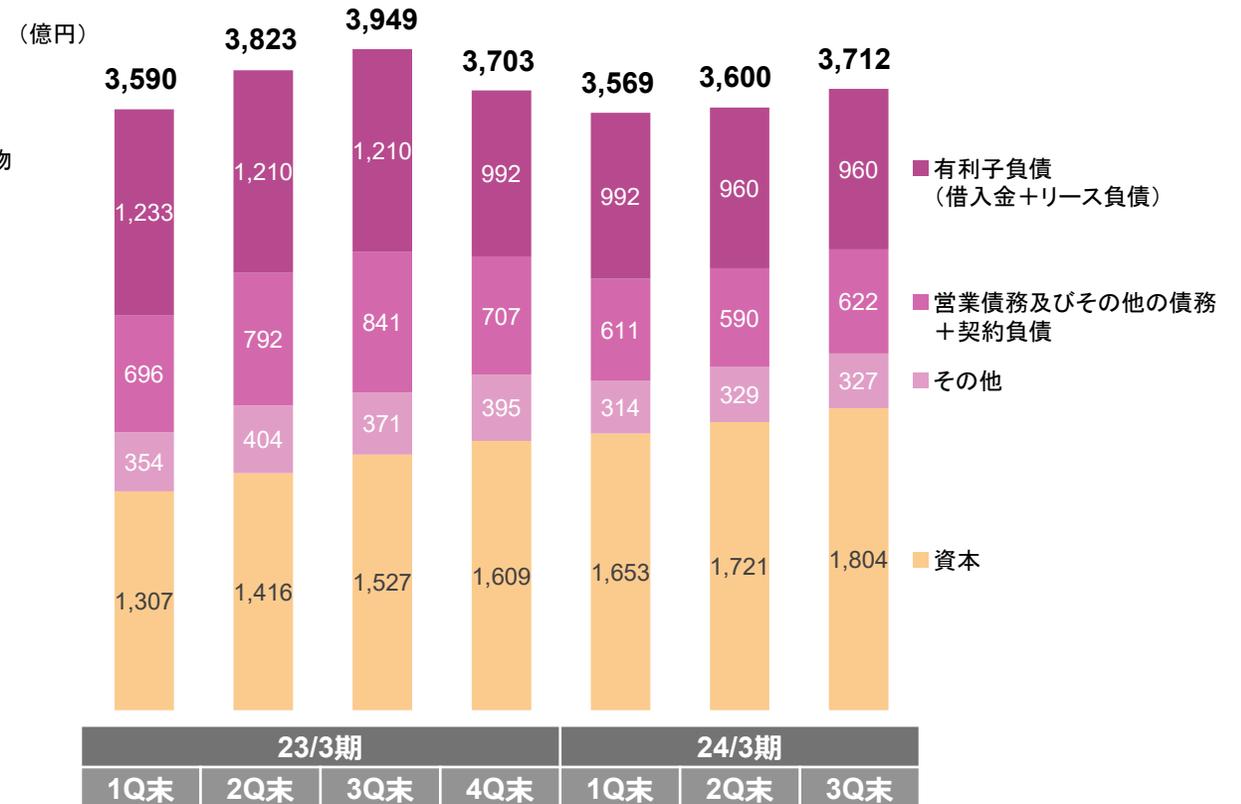
資産合計は、現金・現金同等物、営業債権等が減少したものの、有形固定資産、棚卸資産が増加し、23/3期末比と概ね同水準。

負債合計は、主に営業債務等、借入金の減少により、23/3期末比で185億円減少。

## 資産



## 負債・資本

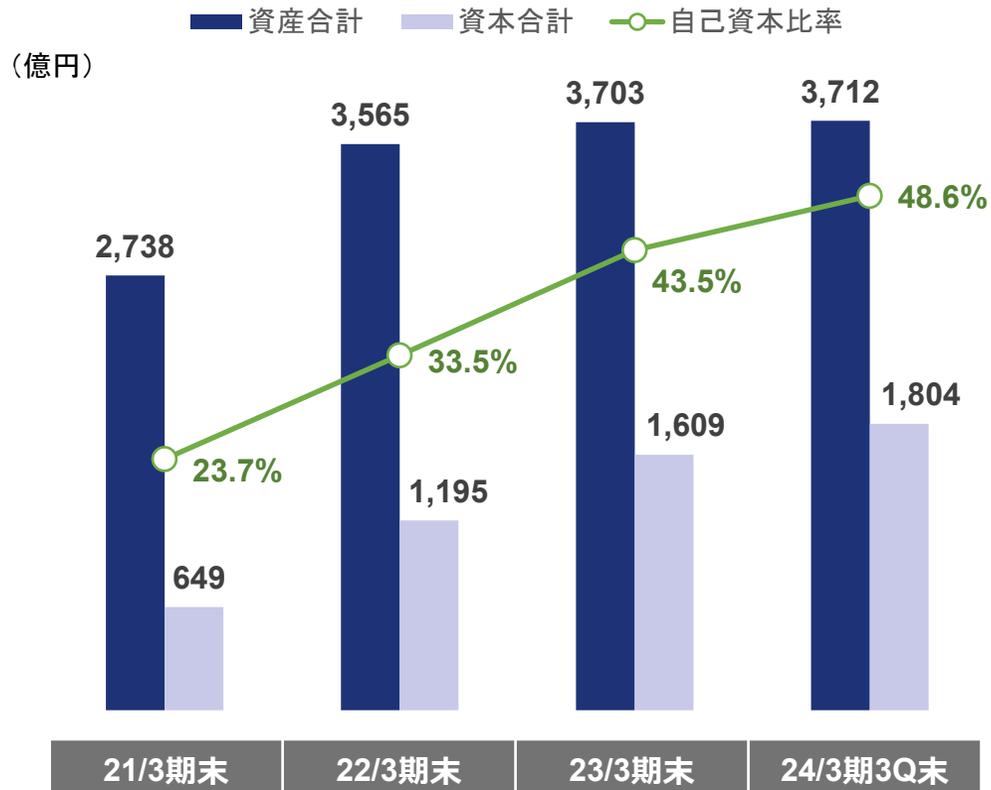


# 自己資本比率 & 現金及び現金同等物 / 有利子負債

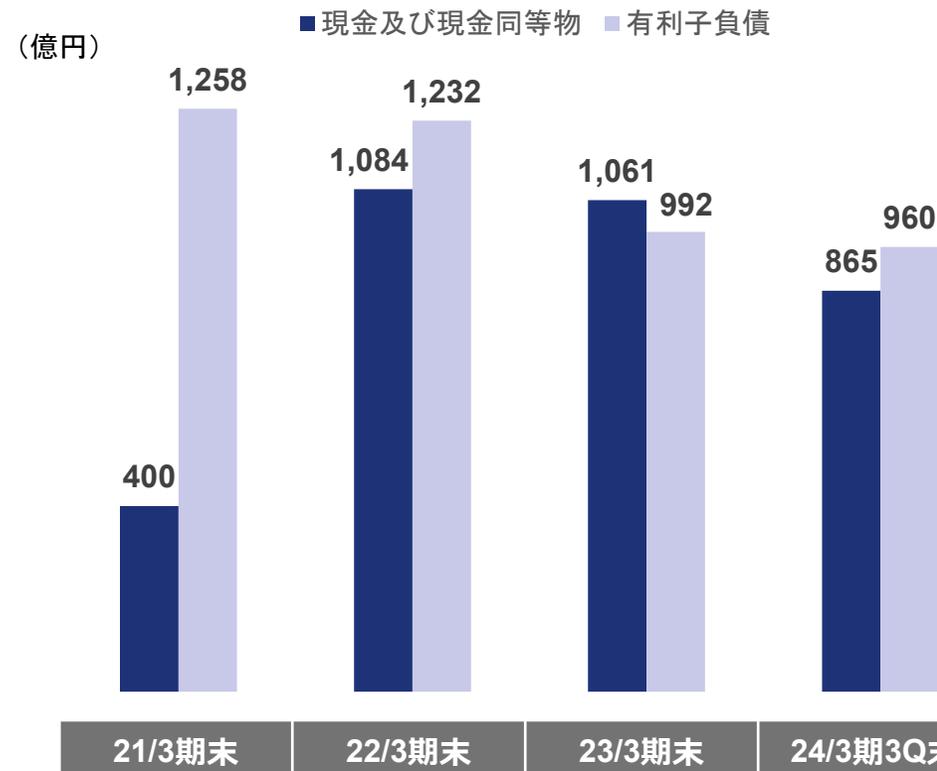
自己資本比率は、3Q末で48.6%に増加。

24/3期は営業CFの悪化により、3Q末のネットデットは95億円。有利子負債は引き続き減少。

### 資産合計 / 資本合計 / 自己資本比率



### 現金及び現金同等物 / 有利子負債



# キャッシュ・フロー

3Qは売上収益の回復に伴って営業CFが回復。現金・現金同等物の四半期末残高は高水準を継続。



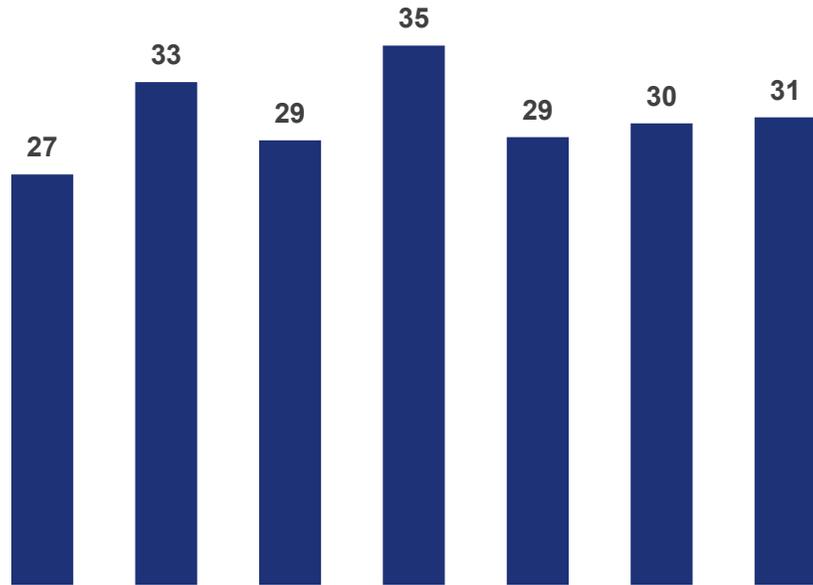
(億円)	23/3期				24/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業CF	△20	+221	△34	+132	△74	△20	+24
投資CF	△10	△17	△21	△31	△53	△20	△33
財務CF	△1	△24	△2	△224	△2	△32	+1
フリーCF	△29	+205	△54	+101	△126	△41	△9
現金及び現金同等物残高	1,065	1,242	1,184	1,061	945	876	865

# 研究開発費／設備投資／減価償却費

次世代製品開発のための投資継続により、研究開発費比率は一時的に増加。売上回復に伴って平常化へ。  
新工場建設やデモルーム拡張など長期償却の大型設備投資が増加。

## 研究開発費

(億円)

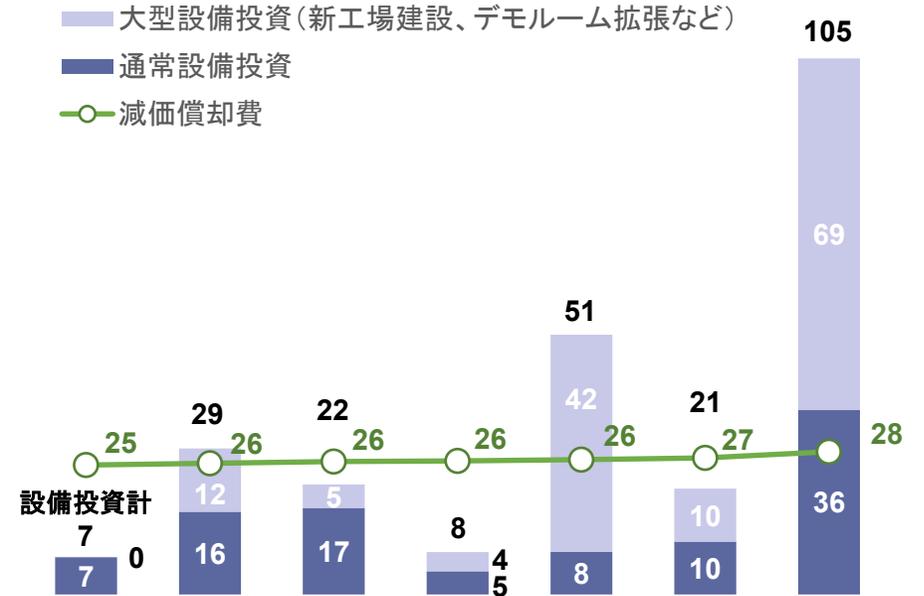


(億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
研究開発費	27	33	29	35	29	30	31
売上収益比	4.8%	5.1%	4.5%	5.9%	9.0%	6.7%	5.7%

## 設備投資／減価償却費

(億円)



(億円)

	23/3期				24/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
設備投資計	7	29	22	8	51	21	105
売上収益比	1.3%	4.4%	3.3%	1.4%	15.5%	4.6%	19.4%
減価償却費	25	26	26	26	26	27	28
売上収益比	4.5%	4.0%	4.0%	4.3%	8.1%	5.9%	5.2%



# 2024年3月期連結業績予想と今後の見通し

## 2024年3月期第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイスの在庫調整が進み、メモリーデバイス単価の上昇も見られ始めたことから、市況は底を打ったと認識。成熟ノードへの活発な投資に加え、DRAM、Logic/Foundryも回復基調へ。
- 当社3Qは前年同期比で減収減益ながら、売上・利益は1Q<2Q<3Qと回復が顕著。受注も計画通り3Qから回復。

## 2024年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、25/3期はWFEを上回る成長を想定。
- 当社売上・利益は1Qを底に、受注は2Qを底に回復に転じており、24/3期通期予想に変更なし。成熟ノード向け投資が活発で売上収益を下支え。今後は先端デバイス向けも回復へ。
- 令和6年能登半島地震による業績への影響は軽微。

# 2024年3月期業績予想

通期業績予想に変更なし。

成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資が業績を下支え。

(億円)	23/3期		24/3期		
	3Q累計	通期	3Q累計	通期(予想)	前期比
売上収益	1,856	2,457	1,317	1,800	△26.7%
売上総利益	769	1,008	559	737	△26.9%
売上総利益率	41.4%	41.0%	42.5%	40.9%	△0.1pts
調整後営業利益	500	643	290	363	△43.6%
調整後営業利益率	26.9%	26.1%	22.1%	20.1%	△6.0pts
調整後当期(四半期)利益	355	460	202	252	△45.3%
調整後四半期利益率	19.1%	18.7%	15.3%	14.0%	△4.7pts
営業利益	449	561	241	291	△48.1%
営業利益率	24.2%	22.8%	18.3%	16.2%	△6.6pts
税引前四半期利益	450	559	236	283	△49.4%
税引前四半期利益率	24.2%	22.7%	17.9%	15.7%	△7.0pts
当期(四半期)利益	320	403	167	202	△49.9%
四半期利益率	17.2%	16.4%	12.7%	11.2%	△5.2pts
1株当たり配当金(円)	-	-	-	11 <sup>*1</sup>	
配当性向	-	-	-	12.5%	

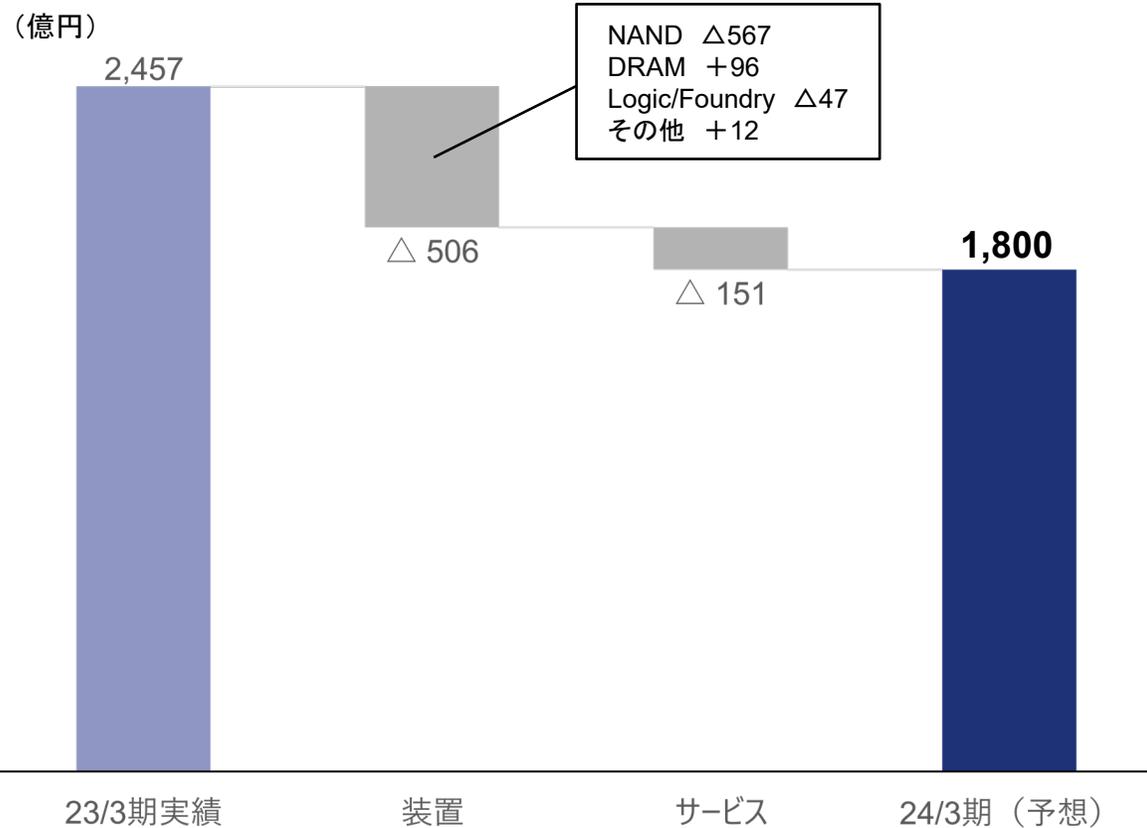
\*1 24/3期予想の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額とし、全額期末配当による支払いを予定しております。

# 2024年3月期業績予想 増減要因

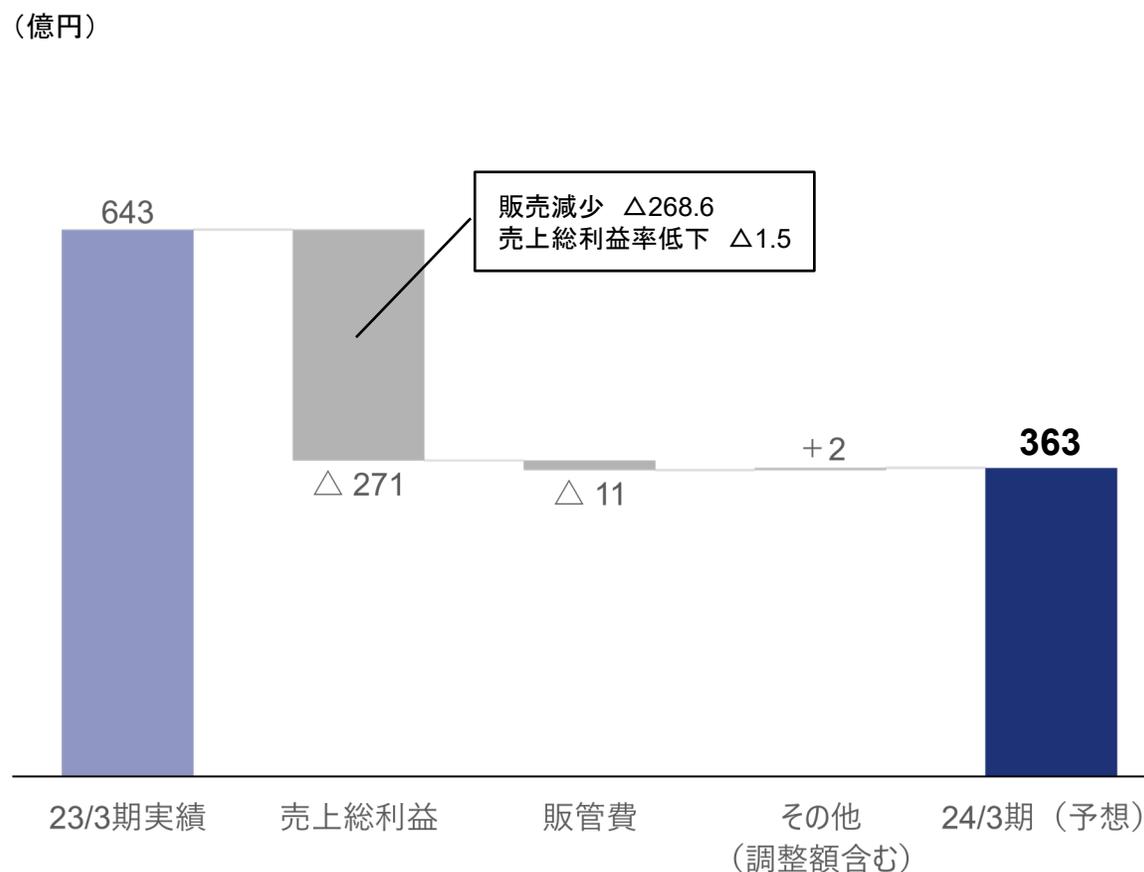
NANDに対する投資抑制の影響により、装置売上が減少する見通し。

販売減少の影響により、調整後営業利益も減少する見通し。

## 売上収益

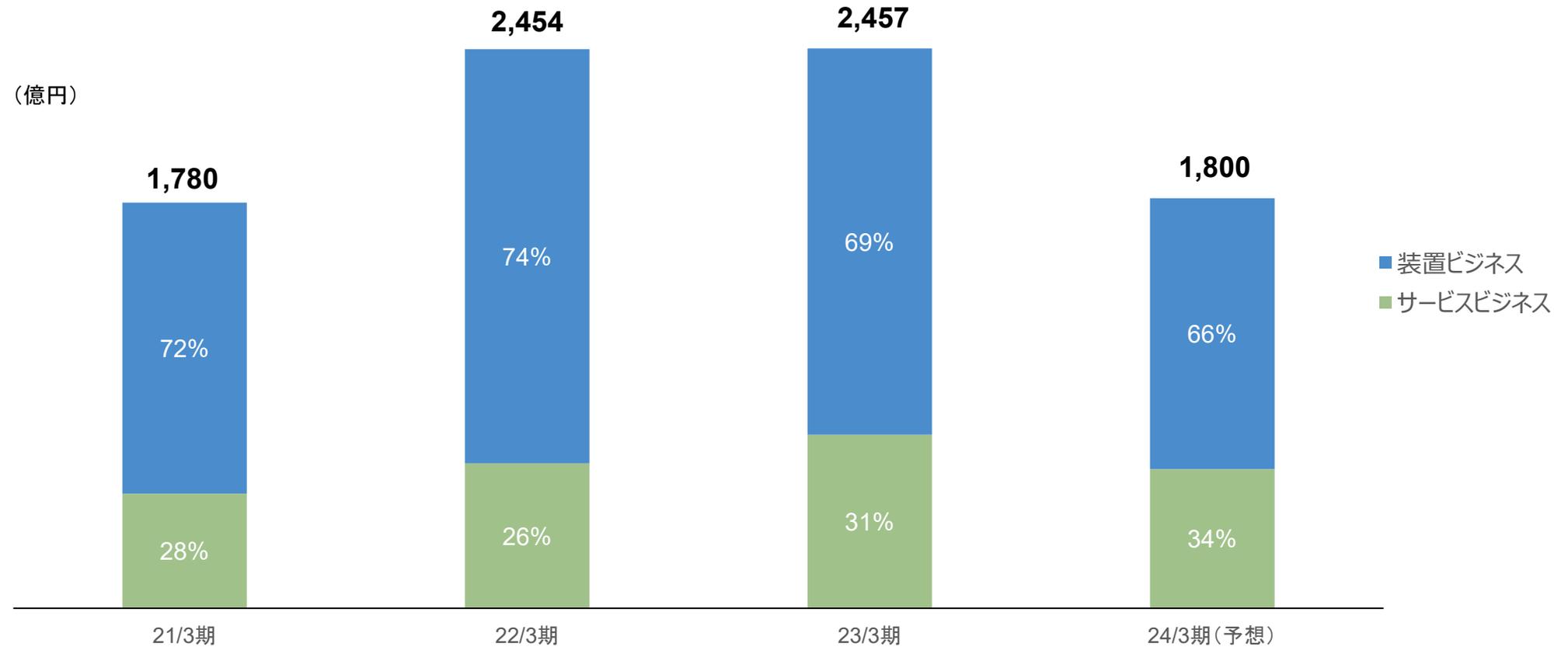


## 調整後営業利益



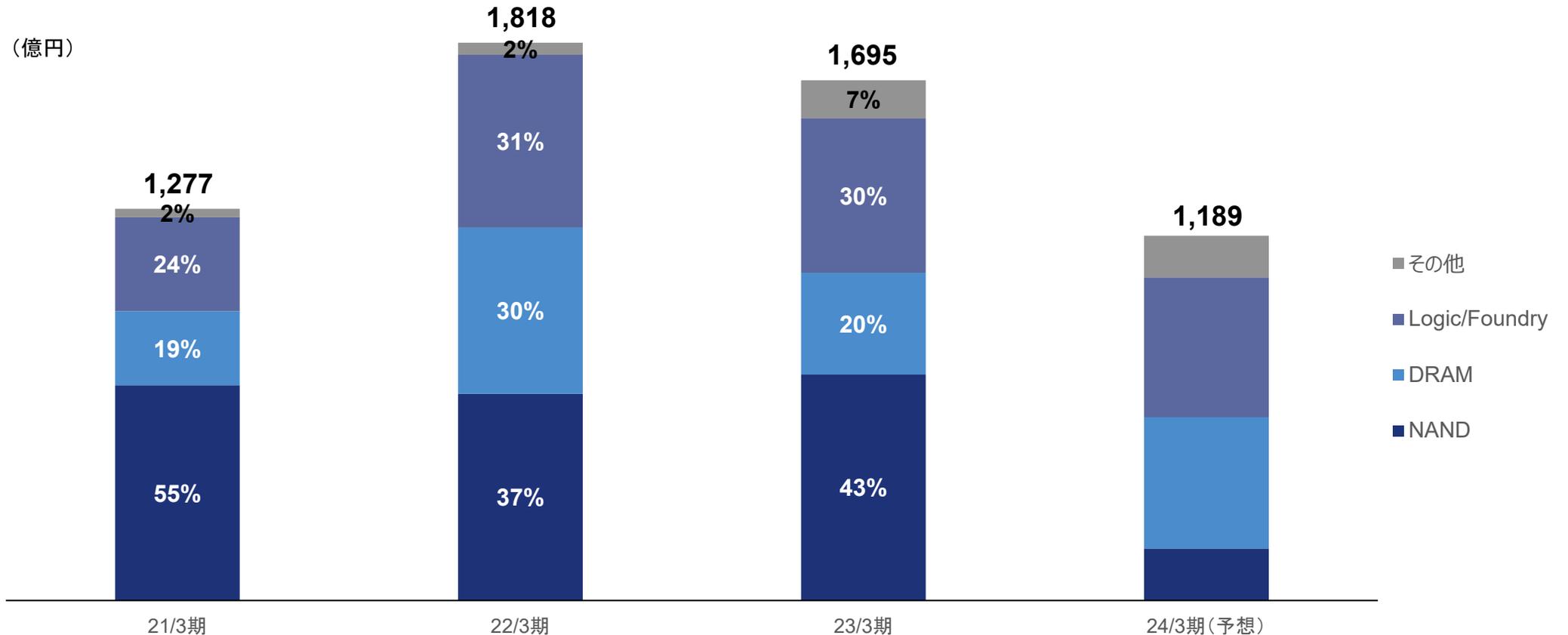
# 売上収益予想 ビジネス別

24/3期は、装置売上の減少により、サービスビジネスの比率が一時的に拡大する見通し。



# 売上収益予想 アプリケーション別(装置のみ)

24/3期は、NANDへの投資抑制が続く中、成熟ノードを含むDRAM、Logic/Foundryへの投資回復により、DRAMとLogic/Foundryの比率が上昇する見通し。



# 事業環境の見通し

## 半導体デバイス・WFE市場の見通し

### ■ 半導体デバイス市場

中長期的には、5G、AI、IoT、DXの拡がりによるデータセンターの拡充や環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が見込まれる。

### ■ WFE市場

24年は23年並みを見込み、今後数年でUSD 110~120bn 程度まで成長すると想定。

半導体デバイスの複雑化・三次元化に伴い、付加価値の高い半導体製造装置の需要拡大が期待される。

中国における成熟ノードへの活発な投資は持続すると想定されるものの、当社は慎重な見方を継続。今後はグローバル市場が回復基調へ。

## 24/3期及び25/3期の装置売上見通し

■ 24/3期の装置売上は23/3期比で大きく減少するものの、1Qを底に回復が顕著。25/3期はWFEを上回る成長を想定。

### ■ アプリケーション別のトレンド

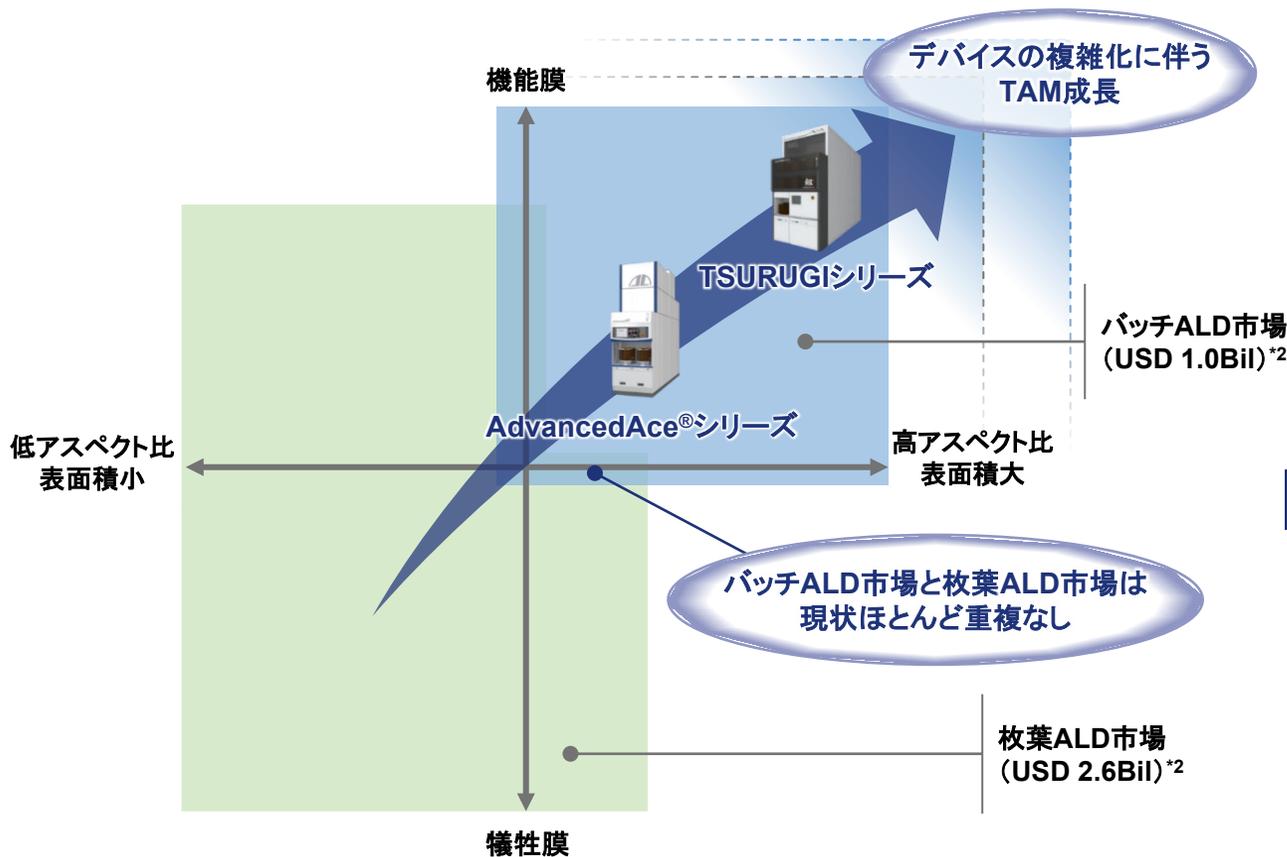
DRAM	<ul style="list-style-type: none"><li>・最も安定した受注・売上を想定。中国向け成熟ノードの需要増加に加え、グローバルでの先端デバイスの需要増加を見込む。</li><li>・生成AIの普及によるHBM*1需要拡大の後押しもあり、DRAMの需要拡大が期待される。</li></ul>
Logic/Foundry	<ul style="list-style-type: none"><li>・足元では中国向け成熟ノードが牽引し、その後はグローバルでの先端デバイス向けの量産立ち上がりを見込む。</li><li>・GAA*2の開発用途POR*3の獲得も進んでおり、25/3期から売上貢献しはじめ、その後の需要拡大が期待される。</li></ul>
NAND	<ul style="list-style-type: none"><li>・足元では開発用途装置の需要持続を見込む。</li><li>・市況は25/3期後半から回復に転じ、26/3期での本格的な量産回復が期待される。</li></ul>
SiCパワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"><li>・24/3期、25/3期は既存製品で売上拡大を見込む。</li><li>・26/3期以降は高温活性化アニール新製品での急成長が期待される。</li></ul>

\*1 HBM: High Bandwidth Memory(高帯域幅メモリー)の略 \*2 GAA: Gate All Aroundの略 \*3 POR: Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。

# バッチALDの優位性

デバイスの複雑化に伴い、バッチALD<sup>\*1</sup>市場は拡大。枚葉ALD市場とすみ分けながら、NANDのみならずDRAM、LogicでもバッチALDに対するニーズは強まっていく見通し。

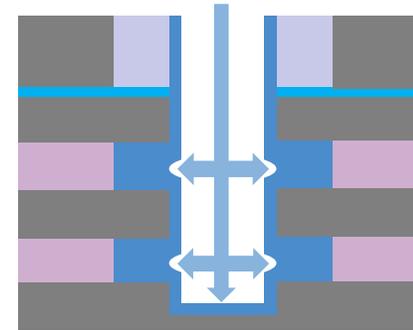
## バッチALD市場のポジショニング



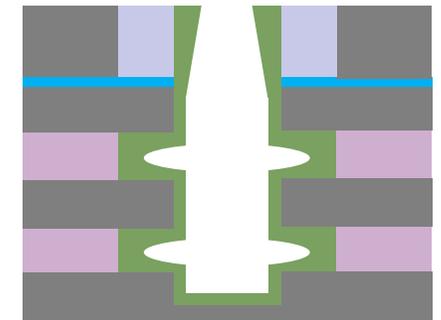
\*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼ぶ。  
 \*2 公開情報・当社売上収益に基づき当社推定 \*3 Gate All Aroundの略

## 当社バッチALDプロセスの特徴

- サーマルを用いたバッチALD技術による縦・横方向へのステップカバレッジに優れた成膜
- バッチ成膜による高い生産性

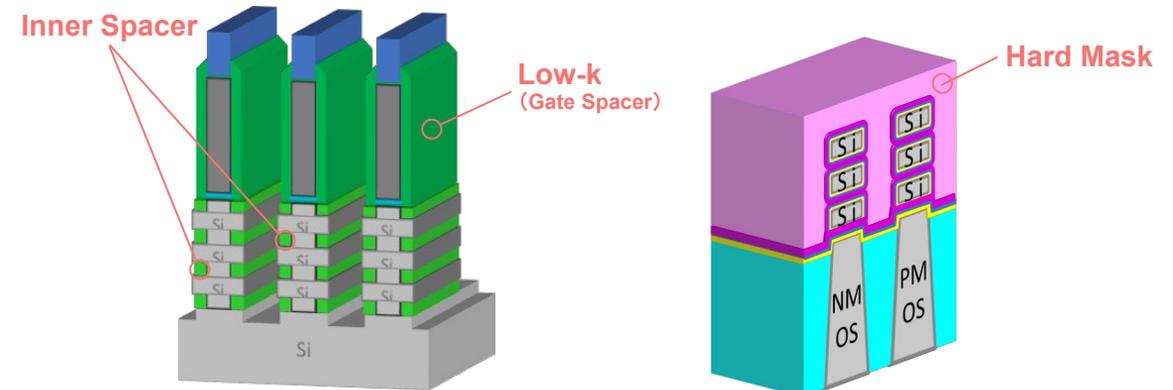


先端バッチALDプロセス(サーマル)での成膜イメージ



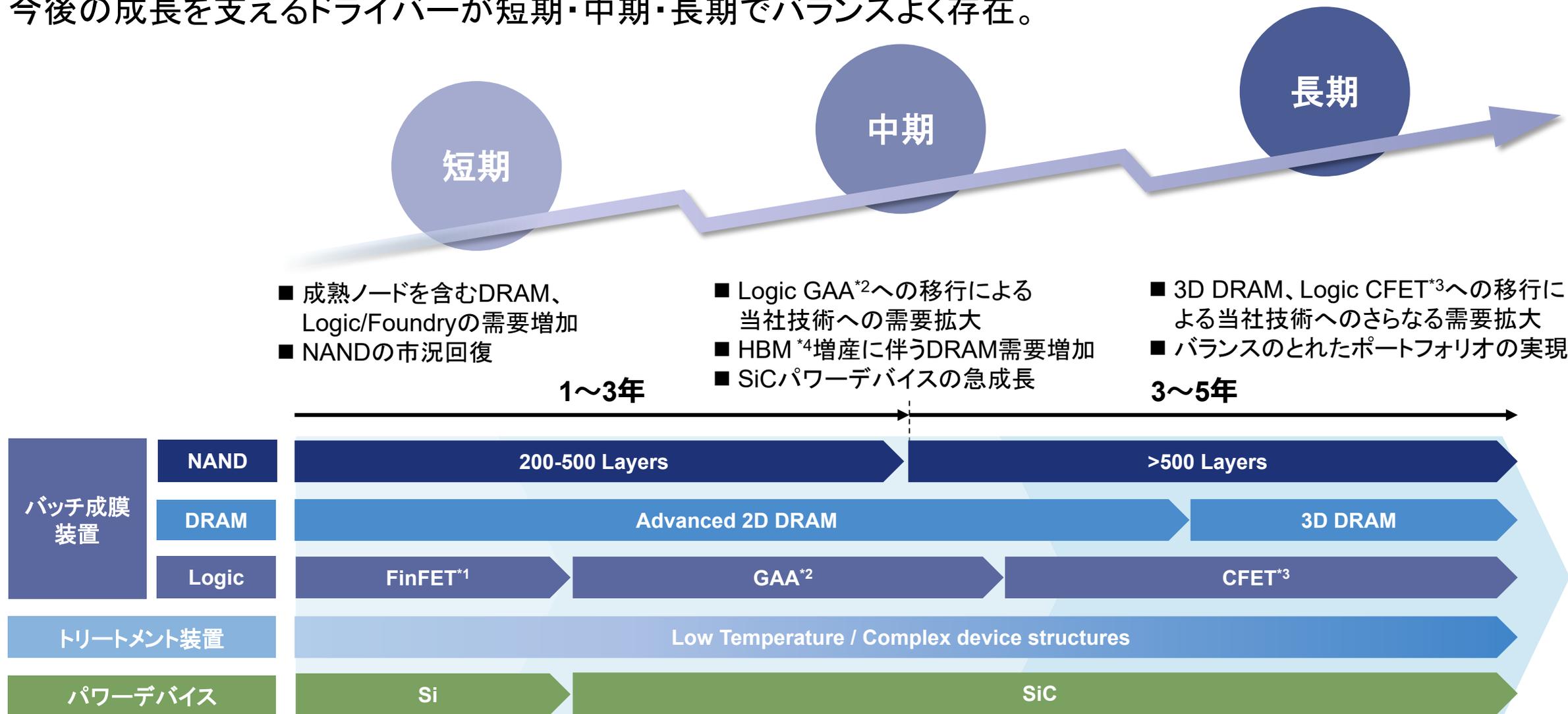
従来プロセスでの成膜イメージ

## Logic GAA<sup>\*3</sup>においてバッチALDの需要が増加



# 今後のビジネス展開

今後の成長を支えるドライバーが短期・中期・長期でバランスよく存在。



\*1 Fin Field-Effect Transistorの略 \*2 Gate All Aroundの略 \*3 Complimentary Field Effect Transistorの略 \*4 HBM:High Bandwidth Memory(高帯域幅メモリー)の略



# Appendix

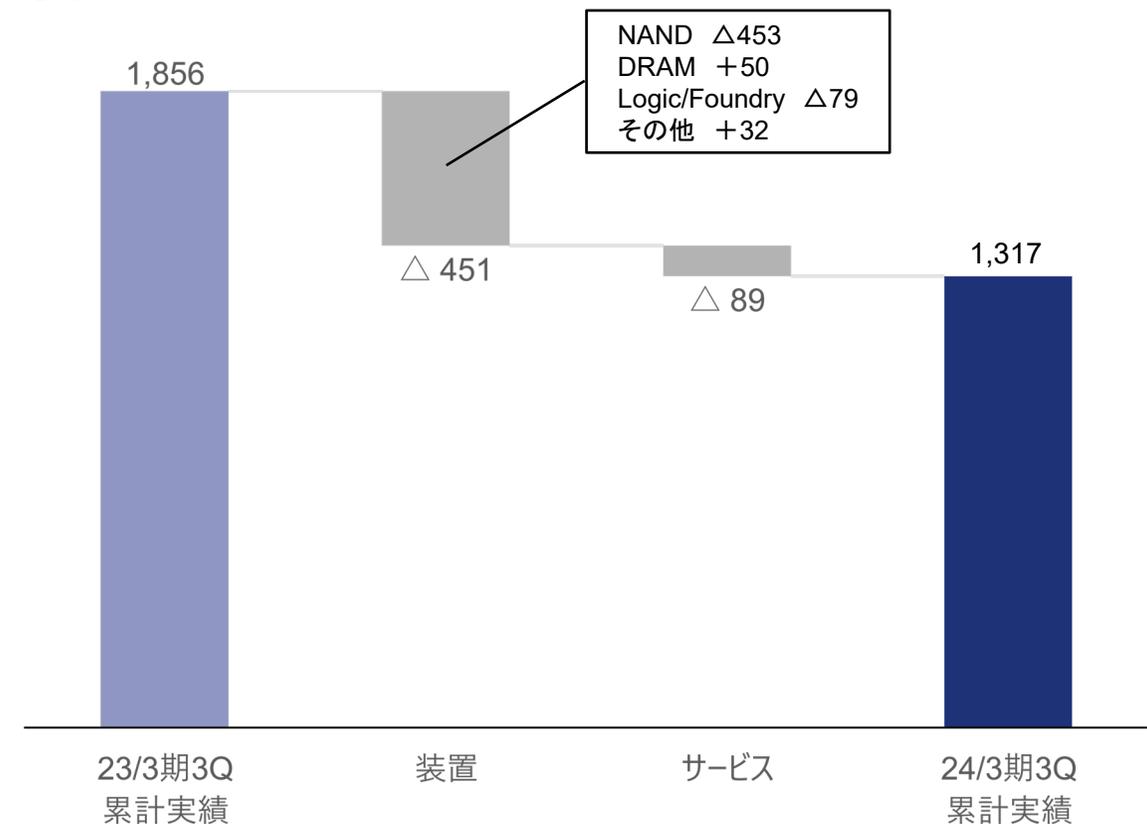
# 2024年3月期第3四半期(累計)実績 増減要因

NANDに対する投資抑制により、売上収益は前年同期比▲540億円。

販売減少の影響を売上総利益率の改善が一部相殺し、調整後営業利益は前年同期比▲209億円。

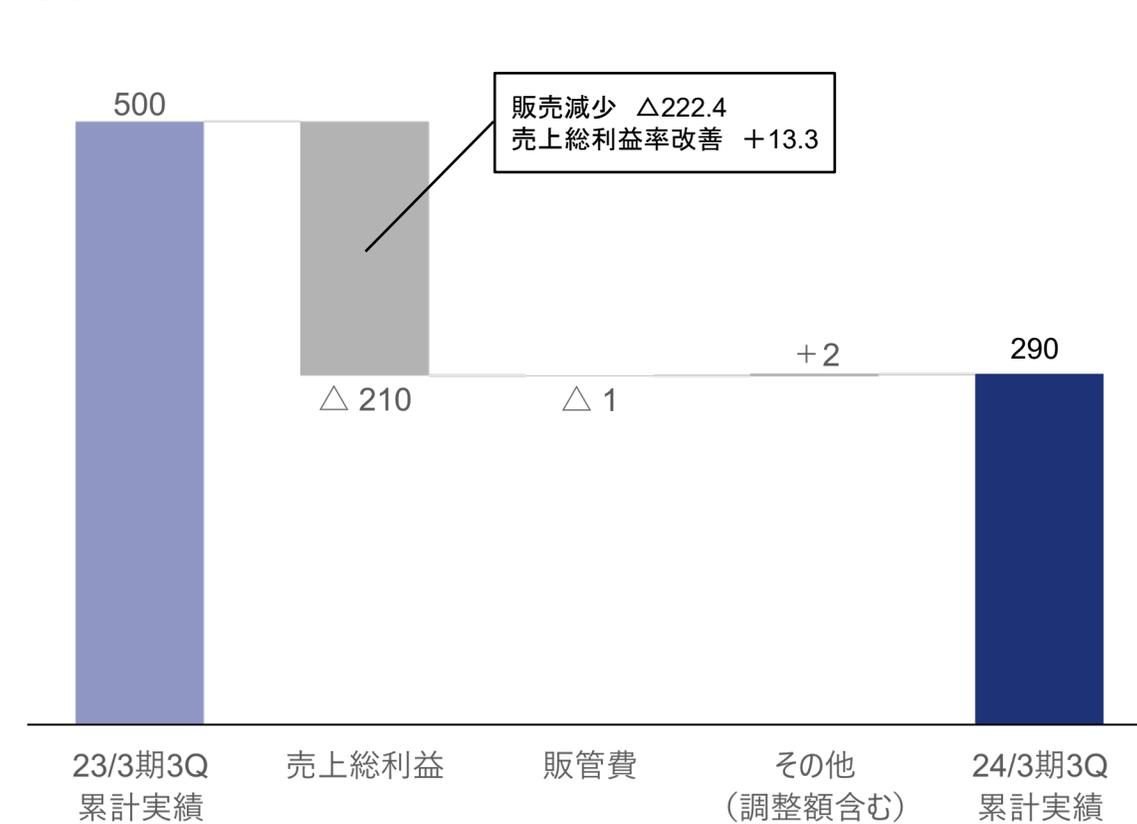
## 売上収益

(億円)



## 調整後営業利益

(億円)



# 損益計算書及び研究開発費、設備投資、減価償却費

(百万円)	23/3期					24/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q
売上収益	56,035	64,385	65,216	60,085	245,721	32,710	44,995	53,956
売上総利益	23,090	27,489	26,359	23,867	100,805	14,275	19,890	21,741
売上総利益率	41.2%	42.7%	40.4%	39.7%	41.0%	43.6%	44.2%	40.3%
調整後営業利益	14,700	18,102	17,154	14,295	64,251	5,614	11,035	12,400
調整後営業利益率	26.2%	28.1%	26.3%	23.8%	26.4%	17.2%	24.5%	23.0%
調整後四半期利益	10,796	12,473	12,193	10,523	45,985	3,782	7,304	9,101
調整後四半期利益率	19.3%	19.4%	18.7%	17.5%	18.7%	11.6%	16.2%	16.9%
営業利益	12,984	16,407	15,527	11,146	56,064	3,990	9,383	10,689
営業利益率	23.2%	25.5%	23.8%	18.6%	22.8%	12.2%	20.9%	19.8%
税引前四半期利益	12,901	16,429	15,667	10,898	55,895	3,727	9,145	10,742
税引前四半期利益率	23.0%	25.5%	24.0%	18.1%	22.7%	11.4%	20.3%	19.9%
四半期利益	9,605	11,297	11,064	8,339	40,305	2,655	6,158	7,914
四半期利益率	17.1%	17.5%	17.0%	13.9%	16.4%	8.1%	13.7%	14.7%
研究開発費	2,688	3,293	2,912	3,532	12,425	2,932	3,023	3,062
設備投資	736	2,853	2,151	828	6,568	5,077	2,071	10,478
減価償却費	2,529	2,563	2,600	2,612	10,304	2,637	2,671	2,792

# 調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	23/3期					24/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q
<b>営業利益</b>	<b>12,984</b>	<b>16,407</b>	<b>15,527</b>	<b>11,146</b>	<b>56,064</b>	<b>3,990</b>	<b>9,383</b>	<b>10,689</b>
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110	△285
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33	19
(調整額)								
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592	1,593
＋スタンドアローン関連費用	105	16	156	76	353	1	10	203
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127	181
調整額 計	1,723	1,637	1,777	1,758	6,895	1,609	1,729	1,977
<b>調整後営業利益</b>	<b>14,700</b>	<b>18,102</b>	<b>17,154</b>	<b>14,295</b>	<b>64,251</b>	<b>5,614</b>	<b>11,035</b>	<b>12,400</b>
<b>当期(四半期)利益</b>	<b>9,605</b>	<b>11,297</b>	<b>11,064</b>	<b>8,339</b>	<b>40,305</b>	<b>2,655</b>	<b>6,158</b>	<b>7,914</b>
－その他の収益	△30	△30	△191	△19	△270	△30	△110	△285
＋その他の費用	23	88	41	1,410	1,562	45	33	19
(調整額)								
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,593	1,592	1,592	6,369	1,592	1,592	1,593
＋スタンドアローン関連費用	105	16	156	76	353	1	10	203
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	26	28	29	90	173	16	127	181
－調整項目に対する税金調整額	△525	△519	△498	△965	△2,507	△497	△506	△524
<b>調整後当期(四半期)利益</b>	<b>10,796</b>	<b>12,473</b>	<b>12,193</b>	<b>10,523</b>	<b>45,985</b>	<b>3,782</b>	<b>7,304</b>	<b>9,101</b>

# 貸借対照表及び主要財務指標

(百万円)		23/3期		24/3期	
		4Q末	1Q末	2Q末	3Q末
資産	流動資産				
	現金及び現金同等物	106,053	94,493	87,550	86,498
	営業債権及びその他の債権	47,477	28,967	33,588	37,219
	棚卸資産	67,197	80,273	86,283	86,820
	その他	1,917	1,809	1,213	1,237
	流動資産合計	222,644	205,542	208,634	211,774
	非流動資産				
	有形固定資産	18,775	23,227	24,325	33,556
	のれん	59,065	59,065	59,065	59,065
	無形資産	62,968	61,420	59,941	58,475
その他	6,811	7,651	8,074	8,323	
非流動資産合計	147,619	151,363	151,405	159,419	
資産合計	370,263	356,905	360,039	371,193	

(百万円)		23/3期		24/3期	
		4Q末	1Q末	2Q末	3Q末
負債	流動負債				
	借入金＋リース負債	6,596	6,582	7,298	7,256
	営業債務及びその他の債務	41,790	28,982	29,645	37,777
	契約負債	28,918	32,068	29,354	24,427
	その他	20,873	13,293	14,461	14,238
	流動負債合計	98,177	80,925	80,758	83,698
	非流動負債				
	借入金＋リース負債	92,610	92,570	88,743	88,696
	その他	18,595	18,081	18,402	18,445
	非流動負債合計	111,205	110,651	107,145	107,141
負債合計	209,382	191,576	187,903	190,839	
資本合計	160,881	165,329	172,136	180,354	
負債及び資本合計	370,263	356,905	360,039	371,193	

	23/3期		24/3期	
	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末
自己資本比率	43.5%	43.5%	47.8%	48.6%
D/Eレシオ	0.6	0.6	0.6	0.5
ネット・キャッシュ(百万円)	6,847	△ 4,659	△ 8,491	△ 9,454

# キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	23/3期				24/3期		
	△Q	2Q	△Q	4Q	△Q	△Q	3Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,950	△22,120	△3,351	△13,174	△7,365	△2,030	△2,443
投資活動によるキャッシュ・フロー	△982	1,657	△2,069	3,117	△5,278	△2,037	△3,321
フリー・キャッシュ・フロー	△2,932	△20,463	△5,420	△10,057	△2,643	△4,067	878
財務活動によるキャッシュ・フロー	120	2,425	163	22,405	167	3,171	70
現金及び現金同等物の期首残高	108,399	106,464	124,198	118,403	106,053	94,493	87,550
現金及び現金同等物の四半期末残高	106,464	124,198	118,403	106,053	94,493	87,550	86,498

# 2024年3月期第3四半期(累計)の主な活動報告

## 事業活動

- 各地域で開催された半導体業界の展示会「SEMICON® Japan」(23/12)、「SEMICON® Europa 2023」(23/11)、「SEMICON® Taiwan 2023」(23/9)、「SEMICON® West 2023」(23/7)及び「SEMICON® China 2023」(23/6)に出展。
- 韓国生産拠点デモ評価エリアの竣工式を実施。(23/11)
- 当社が参画する「集積Green-niX研究・人材育成拠点」が 文部科学省「次世代X-nics半導体創生拠点形成事業」に採択。(23/7)
- Intel Corporationより2023 EPIC Distinguished Supplier Awardを受賞。(23/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」を26年連続受賞、また製品の種類別に優れた半導体製造装置サプライヤーを表彰する「THE BEST Suppliers」を受賞。(23/5)



# 2024年3月期第3四半期(累計)の主な活動報告

## ESGの取り組み

- KOKUSAI ELECTRICグループ サステナブル調達ガイドラインの制定、サプライヤーへの周知・説明。(23/10)
- 富山事業所が拠点を構える富山市八尾地区で開催される行事「おわら風の盆」に協賛。(23/9)
- 子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する「くるみん認定」を取得。(23/7)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(23/6)
- 当社グループサプライチェーンにおけるコンプライアンス強化を目的として、「コンプライアンス通報制度」を拡充。(23/6)
- 女性の活躍推進に積極的に取り組む企業の行動原則を示した、女性のエンパワーメント原則(WEPs)に署名。(23/4)





# KOKUSAI ELECTRICグループについて

# KOKUSAI ELECTRIC at a Glance

## 沿革



## 財務概要(23/3期)

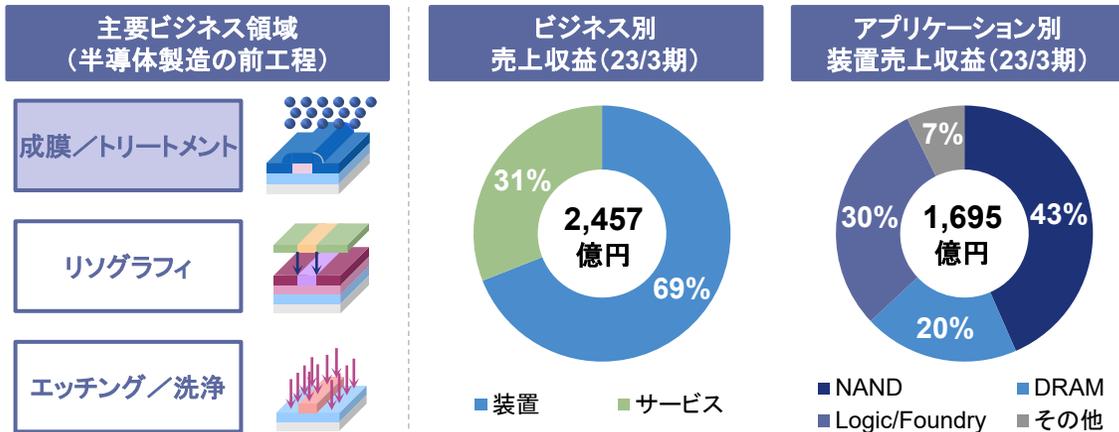


## 会社概要

会社名	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	業種分類	電気機器
銘柄コード	6525	決算期	3月
代表取締役	金井 史幸	会計基準	国際会計基準(IFRS)
従業員数*1	2,469人(連結)、1,127人(個別)	単元株式数	100株
直近の受賞状況			

## 事業概要

当社は半導体製造の前工程における「成膜」プロセスに特化した装置専門メーカー



\*1 2023年9月30日時点

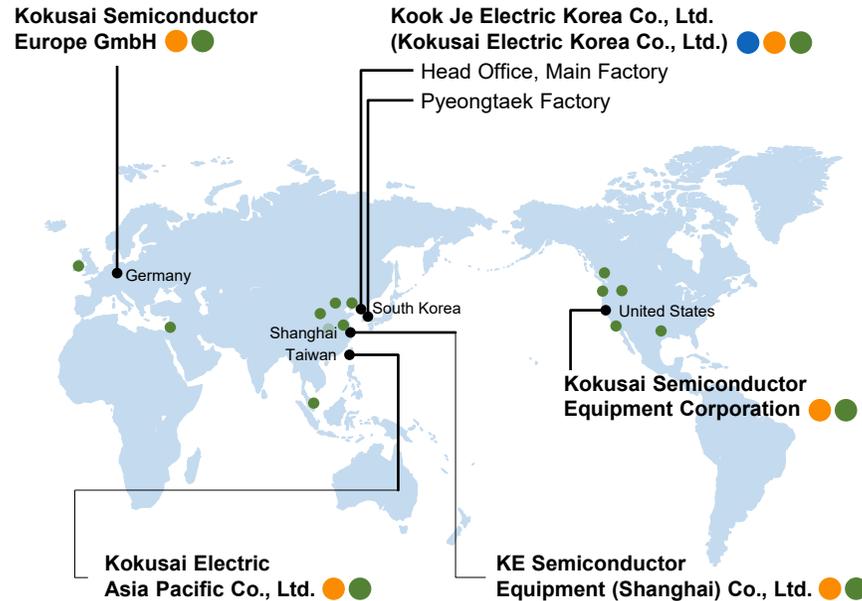
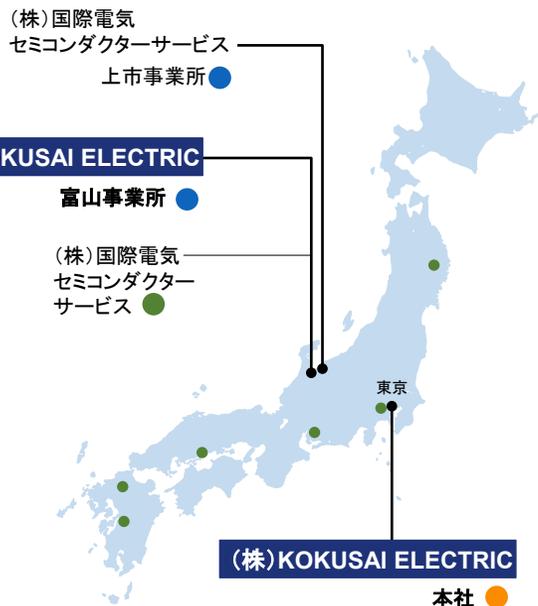
# 事業拠点

製造拠点は富山と韓国、事業拠点はアジア、中国、北米、欧州に展開。  
24年秋の富山新工場の操業開始に伴い、製造・開発キャパシティは大きく拡大へ。

## 事業拠点

### 国内拠点

### 海外拠点



● 製造拠点 ● 販売拠点 ● サービス拠点

## 製造・開発キャパシティ<sup>\*1,2</sup>

製造キャパシティ<sup>\*1</sup>は  
約2倍<sup>\*3</sup>に拡大の見通し



開発キャパシティ<sup>\*2</sup>は  
約1.5倍<sup>\*3</sup>に拡大の見通し



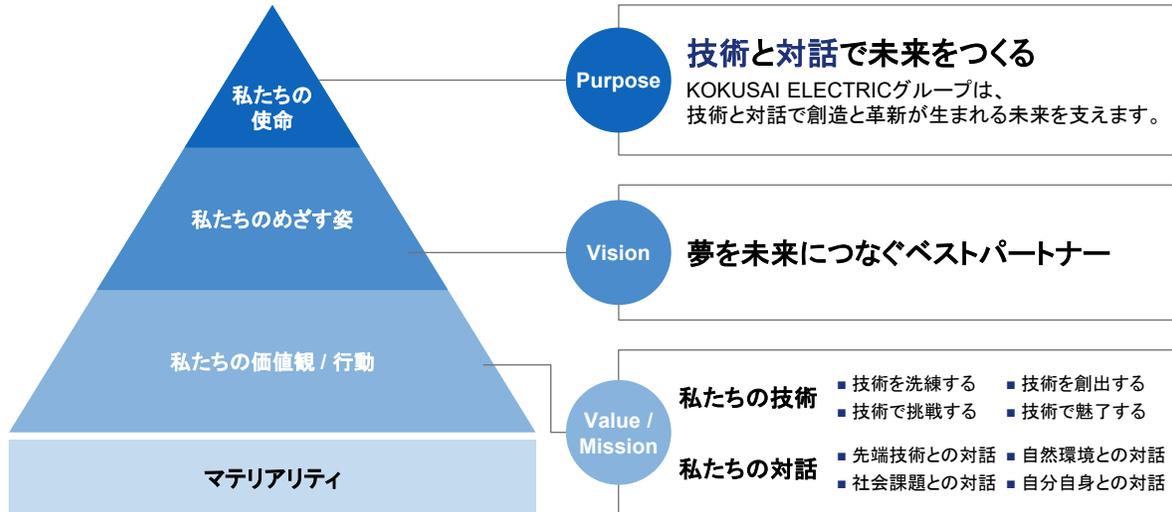
\*1 グラフは最大生産台数/月 \*2 グラフは評価装置台数 \*3 21/3期との比較

# 中長期的な経営方針

“KOKUSAI ELECTRIC Way”（企業理念）に基づき、事業活動とESGの取り組みの両側面から経済価値と環境・社会価値を追求し、SDGsの達成に寄与するとともに、創造と革新が生まれる未来を支え続ける。

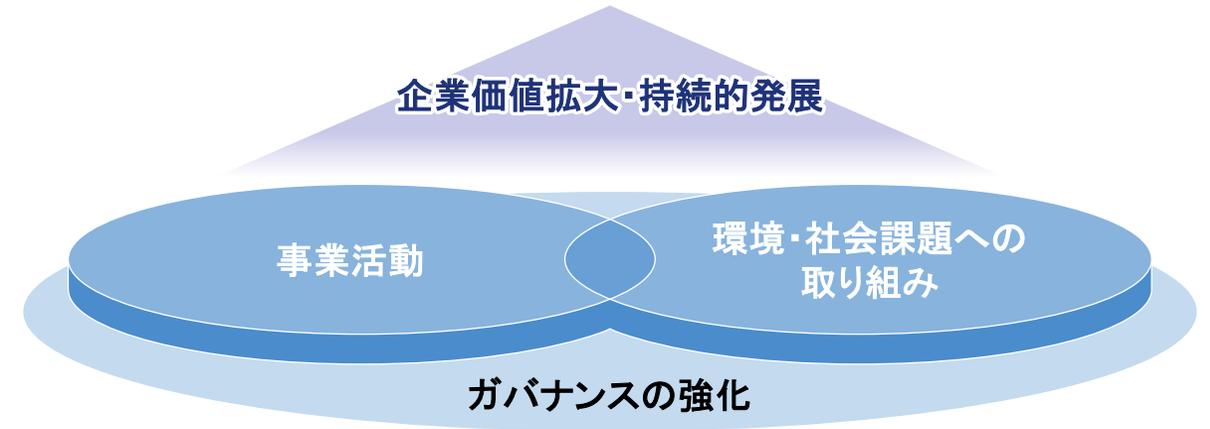
## “KOKUSAI ELECTRIC Way”

### KOKUSAI ELECTRIC Way



## サステナビリティ経営

### 持続可能な社会の実現・SDGs達成への寄与



# 事業内容と主要製品

## 事業内容と23/3期売上収益構成比\*1

### 装置ビジネス(69%)

#### バッチ成膜装置

#### 世界シェア No.1 (2022年)\*2

- 数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD技術に対応可能な装置。デバイスの複雑化に伴い、高難易度成膜と高生産性が求められるようになり、ニーズが拡大。
- ALD: Atomic Layer Depositionの略称。当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼ぶ。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略称。ガスを同時に供給し、気相で化学反応を起こして成膜する手法。当社グループでは、LP-CVD: Low Pressure CVDに集中。

#### バッチALD

#### バッチCVD

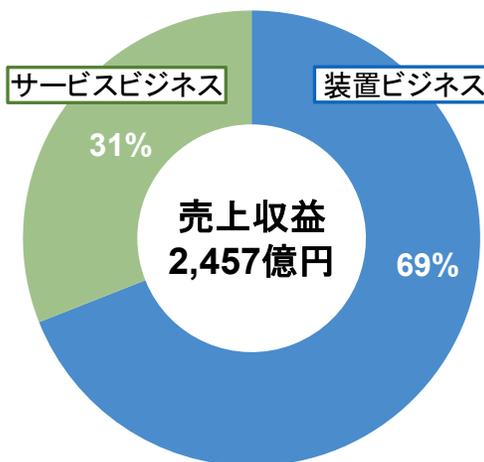
#### トリートメント装置

#### 世界シェア No.2 (2022年)\*3

- 成膜後にプラズマや加熱により膜中の不純物を除去し、粒子を安定させることで、膜質を改善させることを目的とした装置。
- デバイスの複雑化に伴い、等方性と優れたステップカバレッジが求められ、ニーズが拡大。
- 低温環境における膜質改善のニーズが拡大。

### サービスビジネス(31%)

- 当社グループが製造・販売する半導体製造装置のアフターサービス(部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造、ウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置販売など)。
- 部品販売・保守サービスでは、17/3期から23/3期にかけてインストールベースで前期比10%以上の着実な成長を達成。
- “Design for Service Business”のコンセプトでさらなる高付加価値サービスの提供をめざす。



## 主要製品

### ラージバッチ成膜装置「AdvancedAce®-300」



- 高品質な成膜性能と高生産性を備えた装置
- バッチALD技術、バッチCVD技術、酸化技術、拡散技術、アニール技術などに対応

### ミニバッチ成膜装置「TSURUGI-C2® 剣®」



- 次世代対応に向けた成膜性能と高生産性を備えた装置
- 最新のバッチALD技術など薄膜形成プロセスに対応

### 枚葉トリートメント装置「MARORA®」



- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 複雑な半導体形状に対して、高い生産性と品質でのトリートメントが可能

### 枚葉トリートメント装置「TANDUO®」



- 成膜後に加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 低温でのアニールが可能

\*1 当社グループは、半導体製造装置事業の単一セグメントであるため、ビジネスごとに分類して記載 \*2 出典: TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) “TI\_ALD Tools\_YEARLY” 2023 (April)

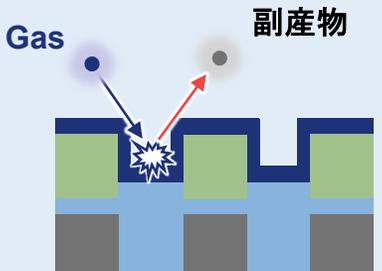
\*3 Gartnerによる半導体製造装置(前工程)セグメントにおける「RTP and Oxidation/Diffusion」を「トリートメント装置」と定義(出典: “Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 17 April, 2023”)

GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

# バッチ成膜装置：デバイス複雑化に伴いバッチALD需要が拡大

デバイス構造の複雑化に伴い、生産性の課題が顕在化、また難易度の高い成膜が不可欠に。  
バッチALD※は、高生産性と高難易度成膜を両立した最適なソリューション。

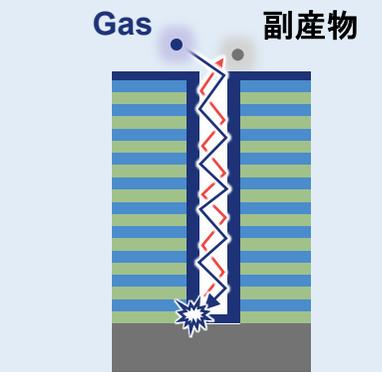
### 2D NANDにおける成膜



Gas 副産物

- 広いスペースでガスの反応が起こるため、ガスの移動距離が短い。
- 成膜が必要な表面積が小さく、またアスペクト比が低い構造。

### 3D NANDにおける成膜



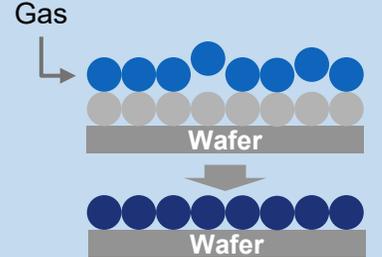
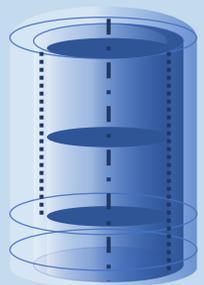
Gas 副産物

- 成膜が必要な表面積が拡大し、ガスの移動距離が長くなるため、成膜にかかる時間が増加。
- 表面積の拡大とアスペクト比の上昇が同時に発生し、難易度の高い成膜が不可欠。



## 高い生産性と難易度の高い高品質成膜の両立が可能なバッチALDの需要が拡大

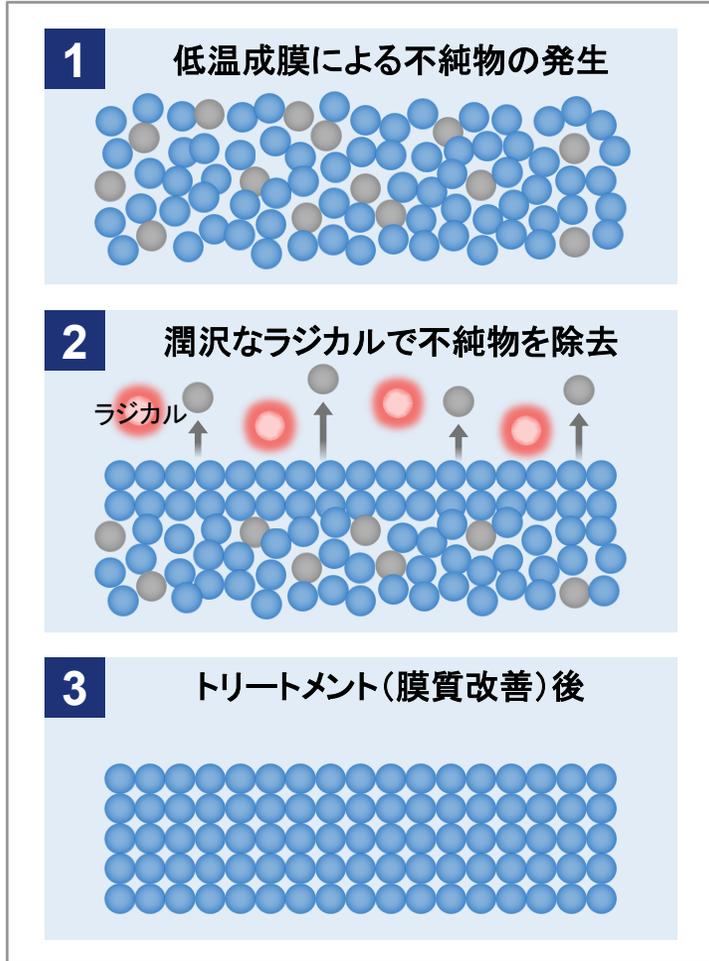
<b>バッチ成膜技術</b> 高生産性	×	<b>ALD技術</b> 高品質
数十枚以上のウェーハを一度に成膜		ウェーハ表面でガスが反応



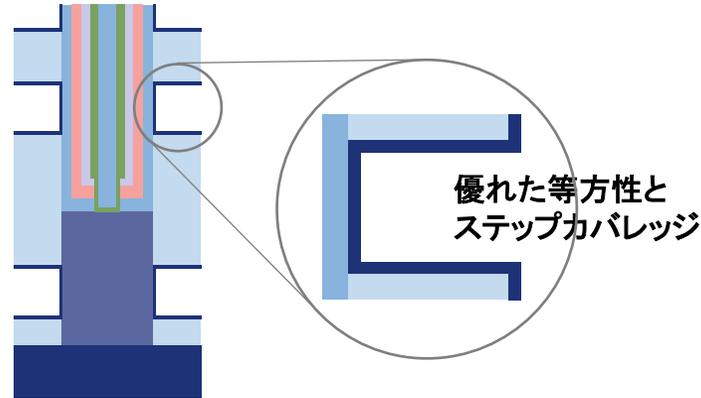
※イメージ

# トリートメント装置：デバイス複雑化に伴いトリートメント需要も拡大

プラズマや加熱による幅広い温度レンジでのトリートメント（膜質改善）が可能。  
高い生産性で優れた等方性、ステップカバレッジを実現するソリューション。



## NAND・DRAMにおけるトリートメント（膜質改善）



- 成膜後に独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、コンフォーマルに膜質を改善。
- 複雑なデバイス構造に対して、高生産性と高品質でのトリートメント（膜質改善）を実現。
- NANDからDRAMへ適用範囲が拡大中。

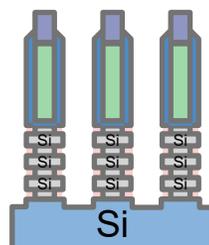
## Logicにおけるトリートメント（膜質改善）

前処理（下地処理）



枚葉トリートメント装置  
MARORA®

選択成膜



後処理（膜質改善）



枚葉トリートメント装置  
MARORA®

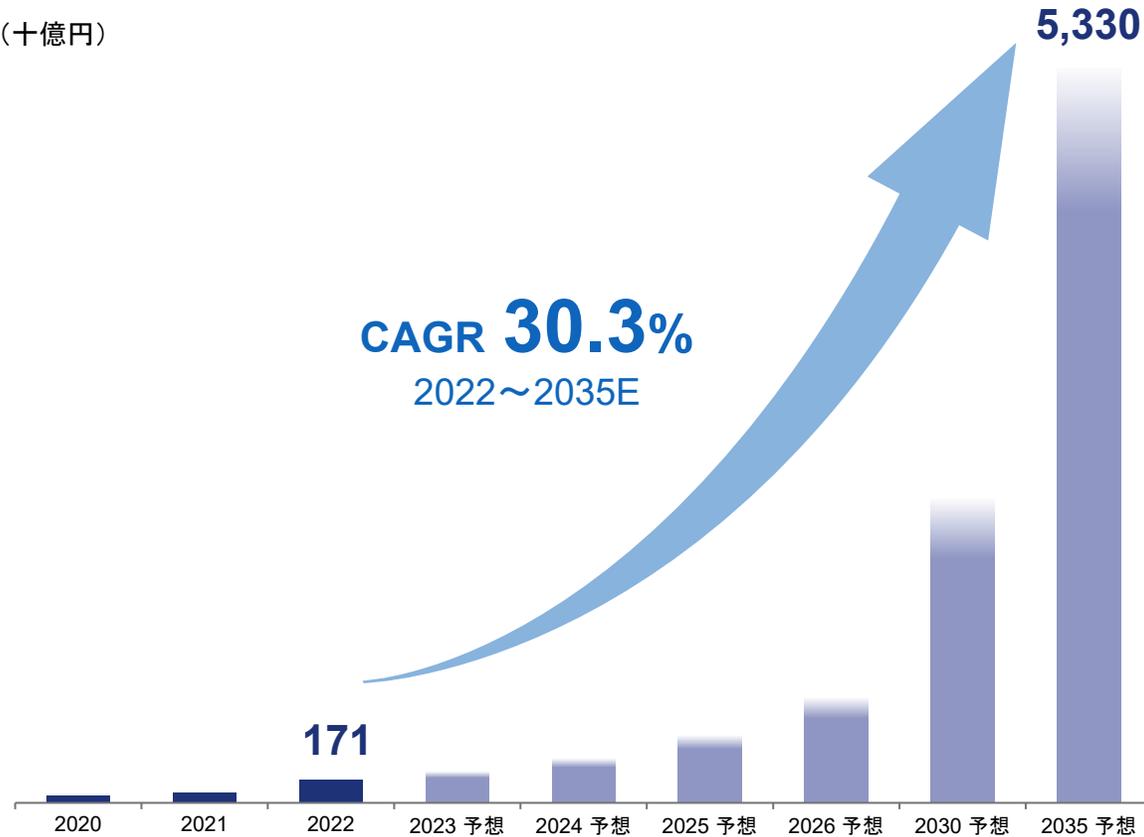
- MARORA®と選択成膜を組み合わせることによりエッチングの工程を短縮し、膜へのダメージを回避。
- MARORA®による前処理（下地処理）と後処理（膜質改善）によって、理想的な選択成膜を実現。

# サービスビジネス: SiCパワーデバイスの急成長

ウェーハサイズ150~200mmのSiCパワーデバイス装置売上が伸長。  
高温活性化アニールの新製品投入によりさらなる事業拡大をめざす。

## SiCパワーデバイスの市場規模\*1

(十億円)

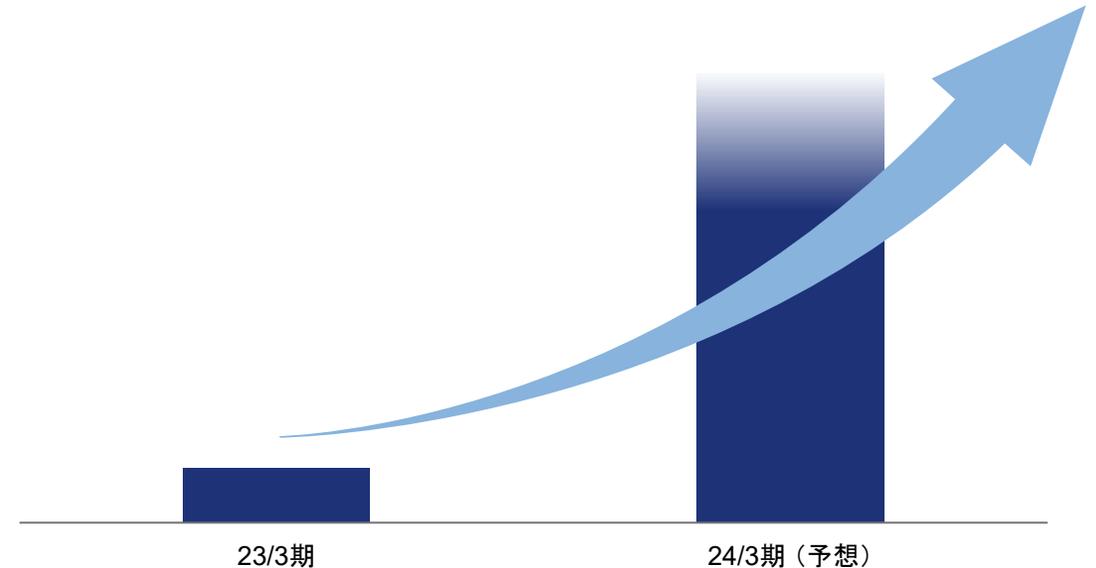


## 当社グループのSiCパワーデバイス売上収益

### 導入予定の新製品

### High Temp Activation Anneal (~2,000C)

- 新たな加熱システムを採用



\*1 出典: 富士経済“2023年版 次世代パワーデバイス&パワエレ関連機器市場の現状と将来展望”

# サステナビリティ経営 マテリアリティ

5つのマテリアリティに基づき、課題解決に向けた活動を推進中。サステナビリティ委員会ではマテリアリティを定期的に見直すとともに、課題ごとに活動計画やKPIに対する進捗をフォローアップ。

マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
<b>■ 創造と革新による社会への貢献</b>	
新技術・新製品の創出	先行要素開発・外部機関との共同開発推進
お客様満足度の向上	VOC <sup>*1</sup> に対応した製品・技術、サービスの提供
経済パフォーマンスの向上	業績・投資等の向上、投資効果の確認
<b>■ 持続可能な社会の創造・地球環境の保全</b>	
環境負荷の低減	温室効果ガスの排出削減
	エネルギー管理の徹底
	廃棄物・有害物質管理の徹底
	水・排水管理の徹底
技術・製品を通じた環境への貢献	環境配慮製品の開発
持続可能な調達の推進	サプライチェーン・マネジメントの強化

\*1 Voice of Customerの略  
\*2 Super Clean Roomの略

マテリアリティ／重点テーマ	マテリアリティに基づく活動アイテム
<b>■ イノベーション創出の源泉となる人財マネジメント</b>	
多様な人財の尊重	ダイバーシティ&インクルージョンの推進
自ら学び、考え、実行する人財の開発	グローバル人財の育成、優秀人財の確保
健康と安全の維持・向上	労働安全衛生マネジメントの強化
<b>■ サステナビリティ経営の実現に向けたガバナンス体制の強化</b>	
ガバナンスの強化	コーポレート・ガバナンスの強化
	コンプライアンスの徹底
重大ビジネスリスク・マネジメントの徹底	SCR <sup>*2</sup> ／CRリスク対策・BCPの強化
	情報セキュリティリスク対策・BCPの強化
経営の透明性確保	適時・適切な社内外への情報開示
<b>■ 人権の尊重・配慮</b>	
人権の尊重	人権に関する社内理解の促進・啓発



## 中長期的な事業戦略・事業目標

# 中長期事業目標

中長期的な成長を見据えて研究開発投資の拡充、製造体制・開発体制の増強をはかり  
売上成長・利益拡大をめざす。

(億円)	22/3期 実績	23/3期 実績	中長期事業目標
売上収益	2,454	2,457	3,000~3,300
装置ビジネス売上比率	74%	69%	70~75%
サービスビジネス売上比率	26%	31%	25~30%
売上総利益	43.6%	41.0%	43.0%以上
研究開発費(対売上収益比率)	4.0%	5.1%	6%程度
調整後営業利益率	32.4%	26.1%	28~30%
(参考)前提としたWFE市場規模	\$90 Bn(2021年)	\$100 Bn(2022年)	\$110~120 Bn

# 株主還元方針

成長投資を最優先に、高い水準での株主還元の実施をめざす。

## 連結配当性向：20～30%程度を目安に配当を実施予定

- 将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的・継続的かつ積極的な利益還元を実施することを、経営の重要課題と位置づけ。

## ネットキャッシュがプラスに転換した後は、自己株式取得を含めたさらなる株主還元をめざす

- ネットキャッシュがプラスに転換した後は、さらなる株主利益と資本効率の向上に向け、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フローの70%程度に相当する金額を配当及び自己株式取得に充当することをめざす。

